



วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีการดำเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1 การเตรียมสารประกอบ  $Pb(Mn_{1/3}Nb_{2/3})O_3 - P(Zr,Ti)O_3$
- 2 การเติมสารที่ช่วยลดอุณหภูมิในการเผาซินเทอร์
- 3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของชิ้นงาน
- 4 การวิเคราะห์สมบัติทางเพียโซอิเล็กทริกของชิ้นงาน

3.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

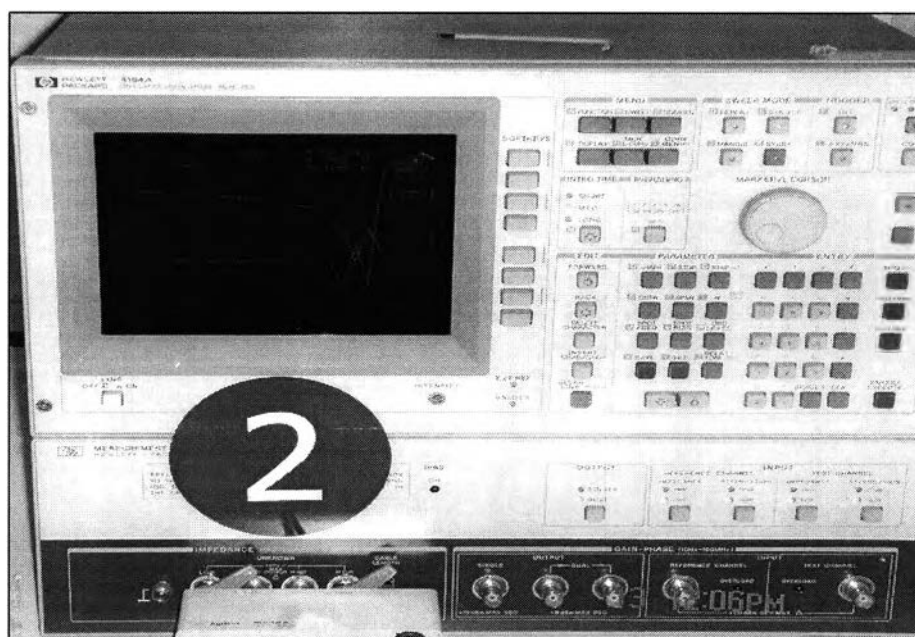
ตารางที่ 3.1 แสดงถึงสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย

ชื่อสารเคมี	บริษัท	ลักษณะเฉพาะ
1 Zirconium oxide	Aldrich	Purity > 99 %
2 Manganese oxide	Aldrich	Purity > 99 %
3 Lead oxide	Aldrich	Purity > 99 %
4 Zinc oxide	Aldrich	Purity > 99 %
5 Titanium oxide	Aldrich	Purity > 99 %
6 Niobium oxide	Aldrich	Purity > 99 %
7 Polyvinyl Alcohol	Asia pacific	
8 Ethanol	Merck	Purity > 99 %
9 SiC powder	Merck	0.6 $\mu m$

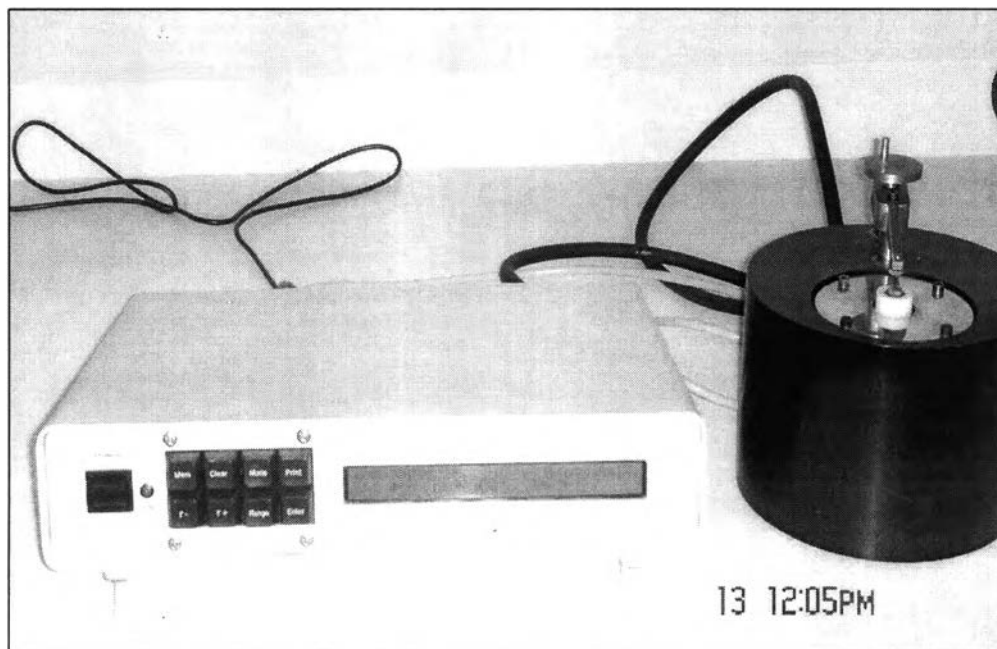
### อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการวิจัย

- 1 เครื่องบด (ball mill)
- 2 เครื่องอัดไฮดรอลิก (hydraulic press)
- 3 เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรคโทรมิเตอร์ (x – ray diffractometer, XRD)
- 4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM)
- 5 เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียโซอิเล็กทริก ( $d_{33}$  meter)
- 6 เครื่องอิมพีแดนซ์อานาไลเซอร์ (impedance analyzer HP4294A)
- 7 เตาเผา (muffle furnace)

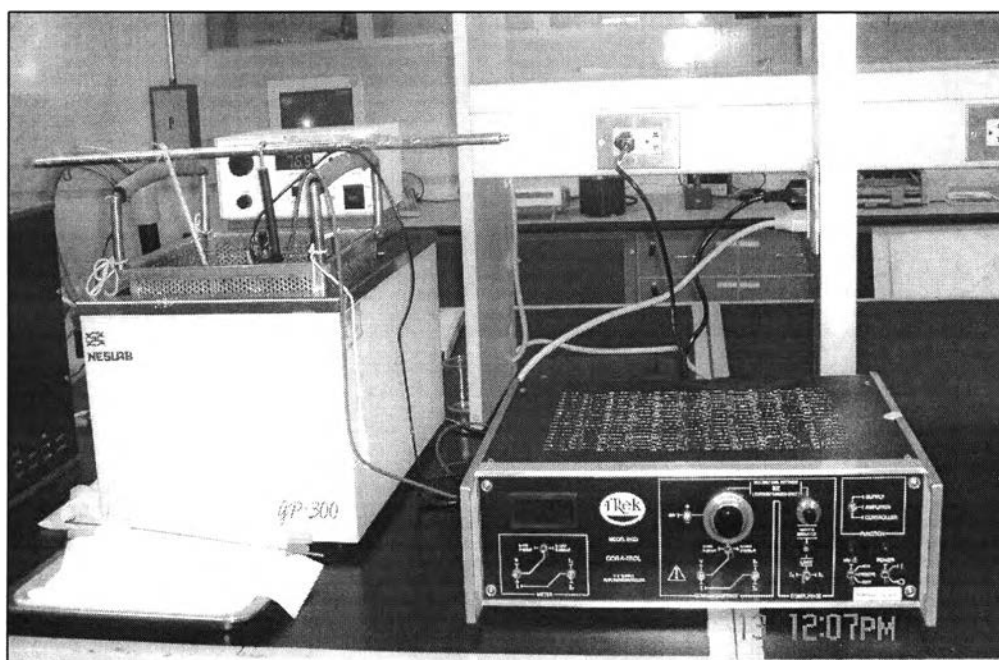
ลักษณะของอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในงานวิจัยแสดงดังรูปที่ 3.1 – 3.3



รูปที่ 3.1 แสดงเครื่องอิมพีแดนซ์อานาไลเซอร์ (impedance analyzer HP4294A)



รูปที่ 3.2 แสดงเครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียโซอิเล็กทริก ( $d_{33}$  meter)



รูปที่ 3.3 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการ โพลขึ้นงาน

### 3.2 ขั้นตอนการสังเคราะห์สาร

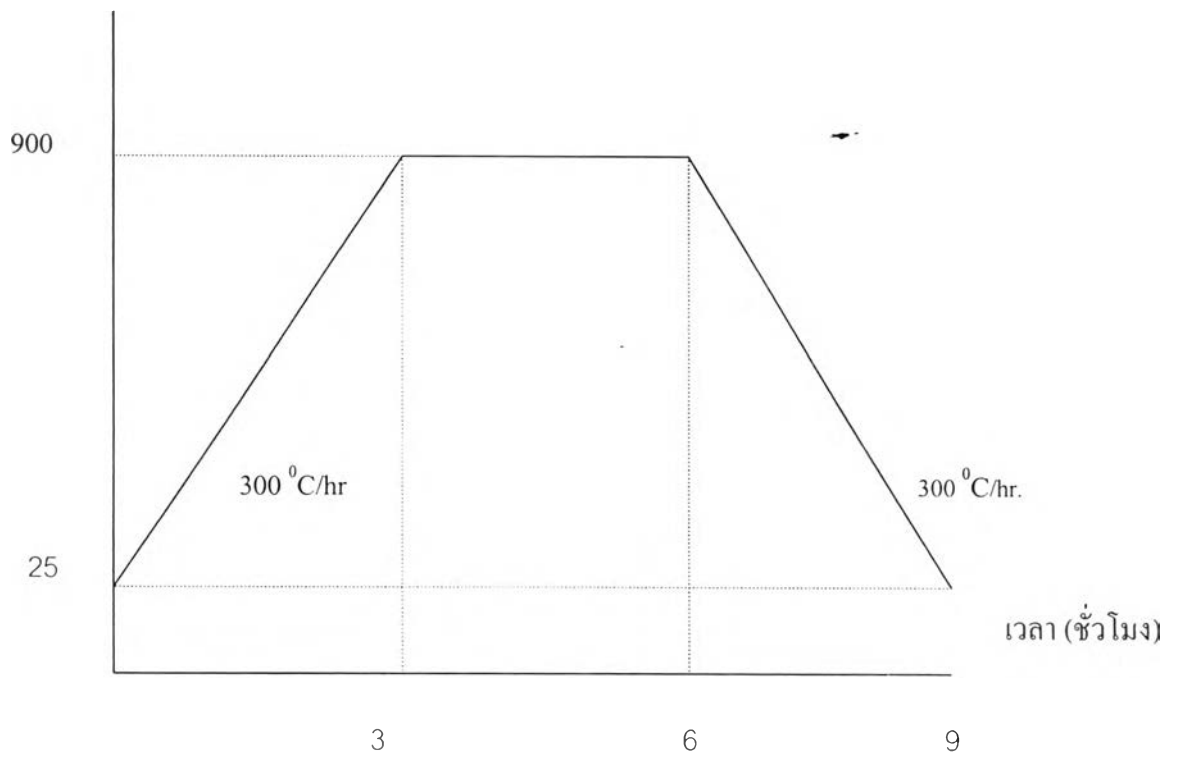
#### 3.2.1 ขั้นตอนในการเตรียมสาร PMnN - PZT

- 1 ชั่งสารให้ได้น้ำหนักดังตารางที่ 3.2
- 2 นำสารตั้งต้นที่ชั่งแล้วบรรจุลงในขวดบดโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งภายในบรรจุลูกบดเซอร์โคเนียประมาณครึ่งขวด
- 3 เติมหेतิลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นตัวกลางในการบดลงไป ในขวดบดให้ได้ประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงของขวดบด
- 4 นำขวดบดที่เปิดฝาสนิทวางบนเครื่องบดแบบบอลมิลล์ โดยใช้เวลาบดประมาณ 24 ชั่วโมงด้วยความเร็ว 258 รอบต่อนาที
- 5 กรองเอาลูกบดออกจนเหลือเฉพาะสารผสมที่ต้องการแขวนลอยอยู่ในเอทิลแอลกอฮอล์
- 6 ระเหยเอทิลแอลกอฮอล์ออกโดยใช้ความร้อนจนกระทั่งเหลือเฉพาะเนื้อสารประกอบ PMnN - PZT
- 7 นำเนื้อสารที่บดแล้วไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ 12 ชั่วโมงจนได้น้ำหนักคงที่
- 8 นำเนื้อสารไปบดกระจายด้วยโกร่งบดที่ทำจากอะลูมินา
- 9 คัดขนาดของสาร โดยการกรองผ่านตะแกรงเบอร์ 100
- 10 นำสารที่ได้ไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยใช้อัตราในการเผา 300 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง ดังรูปที่ 3.4

ตารางที่ 3.2 แสดงถึงปริมาณของสารตั้งต้นที่ใช้

สูตรของสารประกอบ	น้ำหนักต่อ โมล (กรัม)	จำนวน โมลที่ เตรียม	PbO (กรัม)	TiO <sub>2</sub> (กรัม)	MnO <sub>2</sub> (กรัม)	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (กรัม)	ZrO <sub>2</sub> (กรัม)	ZnO (กรัม)	น้ำหนักรวม (กรัม)
$\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})_{0.925}(\text{Mn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_{0.075}\text{O}_3 + \text{ZnO}$ 0%	326.3534	0.3677	82.056	13.0426	0.7992	2.4438	21.8422	0.000	120.4558
$\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})_{0.925}(\text{Mn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_{0.075}\text{O}_3 + \text{ZnO}$ 0.25%	326.3534	0.3677	82.056	13.0426	0.7992	2.4438	21.8422	0.3011	120.7569
$\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})_{0.925}(\text{Mn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_{0.075}\text{O}_3 + \text{ZnO}$ 0.5%	326.3534	0.3677	82.056	13.0426	0.7992	2.4438	21.8422	0.6022	121.058
$\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})_{0.925}(\text{Mn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_{0.075}\text{O}_3 + \text{ZnO}$ 0.75%	326.3534	0.3677	82.056	13.0426	0.7992	2.4438	21.8422	0.9033	121.2851
$\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})_{0.925}(\text{Mn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_{0.075}\text{O}_3 + \text{ZnO}$ 1%	326.3534	0.3677	82.056	13.0426	0.7992	2.4438	21.8422	1.2044	121.5862

อุณหภูมิเคลือบ (°C)



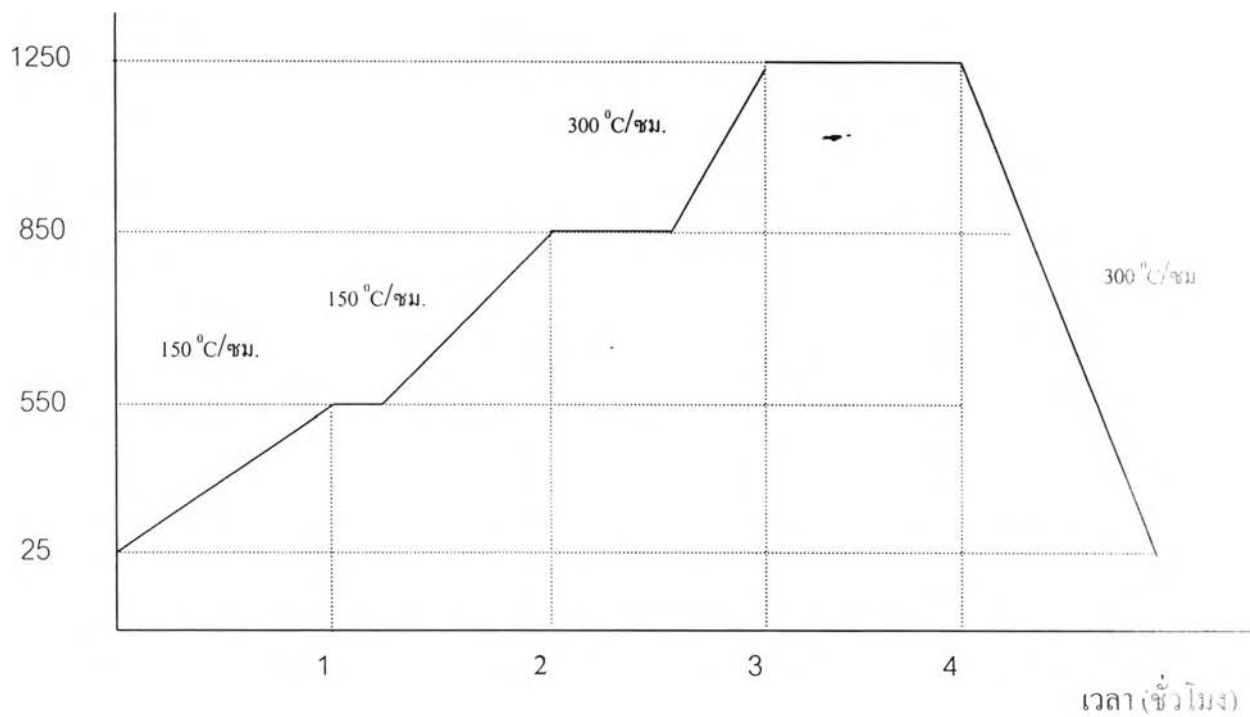
รูปที่ 3.4 แสดงแผนผังในการเคลือบสารเพื่อโซอีเล็กทริก

### 3.2.2 การเติมสารช่วยลดอุณหภูมิในการซินเทอร์

- 1 เติมสารช่วยลดอุณหภูมิในการซินเทอร์ในปริมาณร้อยละ 0, 0.25, 0.5, 0.75 และ 1 โดยน้ำหนัก
- 2 บรรจุในขวดบดโพลีเอททิลีน แล้วนำไปเข้าเครื่องบดแบบบอลมิลล์ 24 ชั่วโมงด้วยความเร็ว 250 รอบต่อนาที เพื่อให้สารที่ได้มีขนาดอนุภาคเล็กลง
- 3 เติมสารละลาย Polyvinyl Alcohol (PVA) ความเข้มข้น 3% จำนวน 3% โดยน้ำหนักของสารเพื่อเป็นตัวช่วยประสานในการขึ้นรูปในชั่วโมงสุดท้ายของการบด
- 4 ระบายจนแห้ง พร้อมทั้งนำไปอบแห้งใ้ให้น้ำหนักคงที่
- 5 บดกระจายด้วยโกร่งบดอะลูมินา
- 6 นำสารที่ได้ไปกรองผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช
- 7 อัดขึ้นรูปเป็นชิ้นงานทรงกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และมีความหนา 1 มิลลิเมตร หนักเม็ดละ 1 กรัมด้วยแรงขนาด 1 ดันต่อตารางเซนติเมตร
- 8 เผาซินเทอร์ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 900, 950, 1000, 1050 องศาเซลเซียสตามลำดับ โดยใช้อัตราการเผาที่ 150 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมงจนกระทั่งถึง 550 องศาเซลเซียส ค้างไว้ 30 นาที แล้วเพิ่มอุณหภูมิในการเผาในอัตรา 150 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง จนกระทั่งถึง 850 องศาเซลเซียส ค้างไว้ 1 ชั่วโมง แล้วเพิ่มอุณหภูมิในการเผา 300 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง จนกระทั่งถึงอุณหภูมิสุดท้ายในการซินเทอร์ โดยค้างไว้ที่อุณหภูมิสุดท้าย 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นลดอุณหภูมิลงจนกระทั่งถึงอุณหภูมิห้องด้วยอัตรา 300 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง โดยลักษณะการเพิ่มลดอุณหภูมิในการซินเทอร์แสดงดังรูปที่ 3.5

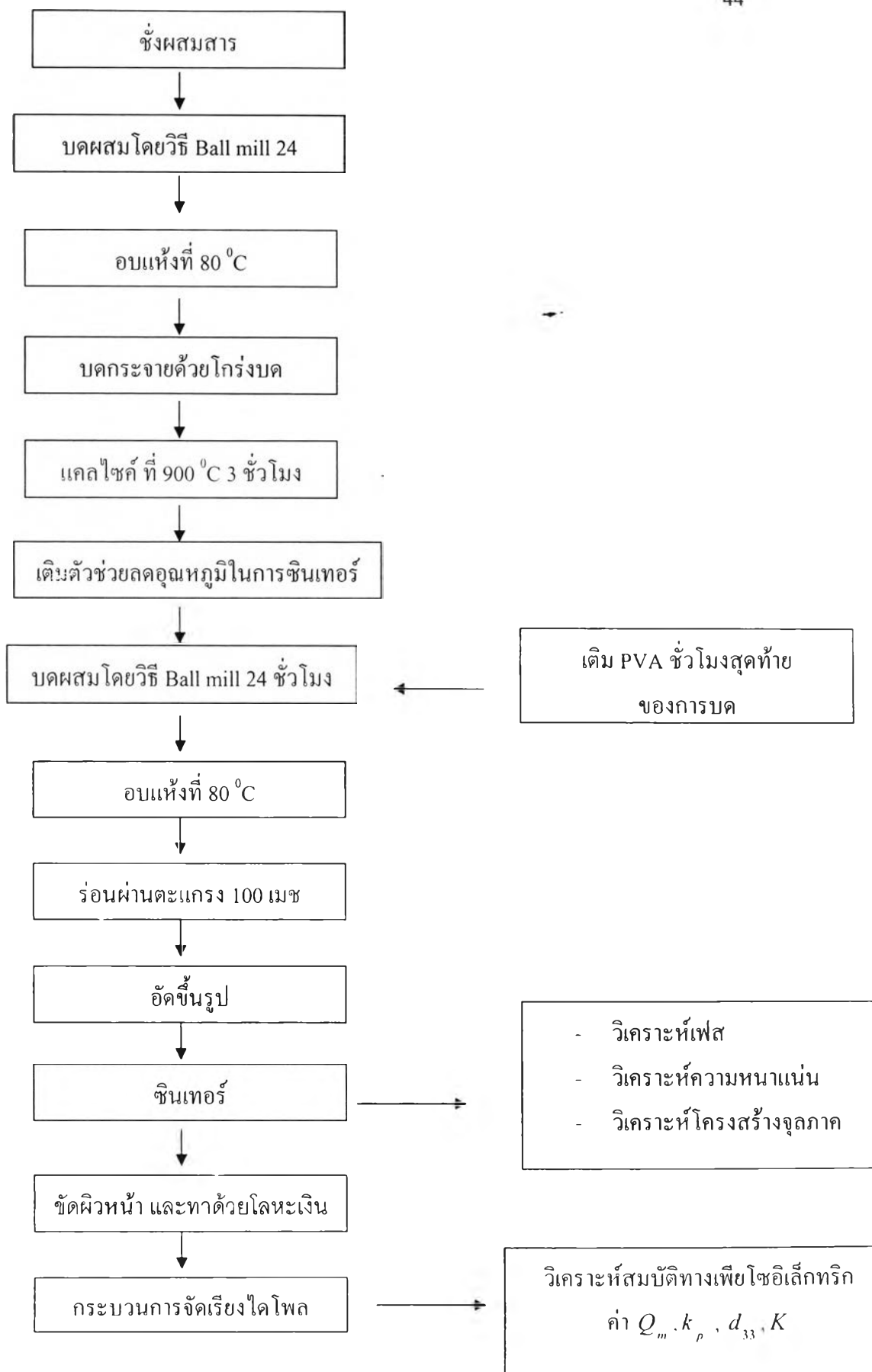
ลักษณะแผนผังของการทดลองเป็นไปตามรูปที่ 3.6

อุณหภูมิซินเทอร์ ( $^{\circ}\text{C}$ )



รูปที่ 3.5 แสดงแผนผังที่ใช้ในการซินเทอร์สารเพียโซอิเล็กทริก





รูปที่ 3.6 แสดงแผนผังขั้นตอนการวิจัย

### 3.3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ

#### 3.3.1 การวิเคราะห์เฟส

การวิเคราะห์เฟสของชิ้นงานนั้นทำการวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง X - ray diffractometer (XRD) เพื่อวิเคราะห์ว่าสารที่ได้นั้นมีเฟสเพอร์รอสไทท์หรือไม่ โดยสารที่ผ่านการซินเทอร์แล้วจะถูกนำไปใส่ในแผ่นอะลูมิเนียมที่รองรับสารตัวอย่างโดยใช้ดินน้ำมันเป็นตัวยึดติดแล้วปิดทับด้วยกระดาษทราย จากนั้นนำไปทดสอบด้วยเครื่อง XRD โดยใช้อัตราการเพิ่มมุมในการกวาด 0.25 องศาต่อนาที และทำการกวาดมุม  $2\theta$  ตั้งแต่ 15 องศา จนกระทั่งถึง 70 องศา ใช้กำลังไฟฟ้า 40 กิโลวัตต์ และกระแส 40 มิลลิแอมแปร์ และใช้  $Cu - K\alpha$  radiation ที่ค่า  $\lambda$  เท่ากับ 1.540 อังสตรอม

#### 3.3.2 การวิเคราะห์ความหนาแน่น

ความหนาแน่นทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีอะคิมีดิส โดยการนำชิ้นงานที่ผ่านการเผาซินเทอร์และจัดปรับขนาดเรียบร้อยแล้วไปอบให้แห้ง จากนั้นก็นำไปชั่งน้ำหนักแห้ง (D) เสร็จแล้วก็นำชิ้นงานไปต้มในน้ำกลั่นด้วยอุณหภูมิที่น้ำเดือดโดยใช้เวลาในการต้ม 6 ชั่วโมง เพื่อต้มเสร็จแล้วก็แช่ชิ้นงานไว้ 24 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำได้ซึมเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานทั้งหมดแล้ว จากนั้นนำชิ้นงานไปชั่งเพื่อน้ำหนักเปียก (W) และชั่งในน้ำเพื่อน้ำหนักแขวนลอย (I) เพื่อนำไปคำนวณหาความหนาแน่นโดยใช้สมการ

$$\rho = \frac{D}{W - I}$$

เมื่อ	$\rho$	คือความหนาแน่น ( $g/cm^3$ )
	D	คือน้ำหนักแห้ง (g)
	W	คือน้ำหนักเปียก (g)
	I	คือน้ำหนักที่ชั่งในน้ำ หรือน้ำหนักแขวนลอย (g)

การวิเคราะห์หาความหนาแน่นตามทฤษฎี

ใช้สมการ

$$\rho = \frac{M}{N_A \times V}$$

- เมื่อ  $\rho$  คือความหนาแน่น ( $\text{g/cm}^3$ )  
 $M$  คือน้ำหนักของสาร 1 โมล ( $\text{g}$ )  
 $N_A$  คือเลขอาโวกาโด  
 $V$  คือปริมาตร ( $\text{m}^3$ )

การหาปริมาตรของหนึ่งหน่วยเซลล์ (unit cell) ตามทฤษฎี

เนื่องจากชิ้นงานที่ได้มีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเตตระโกนอล ซึ่งสามารถที่จะคำนวณหาปริมาตรของชิ้นงานตามทฤษฎีโดยใช้สมการ

$$V = a^2c$$

เมื่อ  $a$  และ  $c$  คือขนาดของผลึกตามแนวทิศ  $a$  และ  $c$  (lattice parameters) ในกรณีนี้เราสามารถหาค่า  $a$  และ  $c$  โดยพิจารณาจากระนาบของพีค (200) และ (002)

สำหรับค่าเลขดิซพารามีเตอร์คำนวณได้จากสมการ

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

ที่พีค (200) 
$$\frac{1}{d_{200}^2} = \frac{2^2 + 0^2}{a^2} + \frac{0^2}{c^2} = \frac{4}{a^2}$$

จะได้ 
$$a = 2 \times d_{200}$$

ที่พีค (002) 
$$\frac{1}{d_{002}^2} = \frac{0^2 + 0^2}{a^2} + \frac{2^2}{c^2} = \frac{4}{c^2}$$

จะได้ 
$$c = 2 \times d_{002}$$

การวิเคราะห์ค่าร้อยละของความหนาแน่นสัมพัทธ์

ค่าร้อยละของความหนาแน่นสัมพัทธ์คำนวณโดยใช้สมการ

$$\% \text{ ความหนาแน่นสัมพัทธ์} = \text{ความหนาแน่นของชิ้นงาน} \times 100 / \text{ความหนาแน่นตามทฤษฎี}$$

### 3.3.3 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

โครงสร้างจุลภาคทำการวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) โดยชิ้นงานที่ผ่านการชินเทอร์และจัดปรับขนาดเรียบร้อยแล้วถูกทำให้นำไฟฟ้าโดยการเคลือบด้วยทองในบรรยากาศสุญญากาศด้วยเครื่อง Ion coater โดยใช้วิธีการเคลือบแบบสเปคโตรริง เป็นเวลา 60 วินาที หลังจากนั้นนำไปส่องด้วยกล้อง SEM โดยการใช้กำลังขยาย 10000 เท่า เพื่อศึกษาคุณลักษณะและโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน หลังจากนั้นถ่ายภาพของชิ้นงานตัวอย่าง

### 3.4 การวิเคราะห์สมบัติทางเพียโซอิเล็กทริก

#### 3.4.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric charge constant, $d_{33}$ )

ชิ้นงานที่ผ่านการทำขั้วแล้วถูกทิ้งไว้ 1 วัน หลังจากนั้นก็นำไปวิเคราะห์ค่า  $d_{33}$  โดยใช้เครื่อง  $d_{33}$  Meter สำหรับการวัดค่าจะวัดที่ชิ้นงานจำนวน 3 ชิ้น โดยในหนึ่งชิ้นงานจะวัดจำนวน 6 จุด โดยการวัดด้านบวก 3 จุด และวัดด้านที่เป็นลบ 3 จุด หลังจากนั้นก็นำมาหาค่าเฉลี่ย

#### 3.4.2 การวิเคราะห์ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant, $K$ )

ชิ้นงานที่ผ่านการทำขั้วแล้วถูกทิ้งไว้ 1 วัน ถูกนำไปวิเคราะห์ค่า  $K$  โดยการวัดค่าความจุไฟฟ้า ( $C$ ) ที่ความถี่ 1 kHz หลังจากนั้นวัดความหนาและพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานเพื่อนำไปคำนวณหาค่า  $K$  โดยการใช้สมการ

$$K = \frac{Ct}{\epsilon_0 A}$$

เมื่อ

$K$  คือค่าคงที่ไดอิเล็กทริก

$C$  คือค่าความจุไฟฟ้า (F)

$t$  คือค่าความหนาของชิ้นงาน (m)

$\epsilon_0$  คือค่าสภาพยอมทางไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ  $8.85 \times 10^{-12}$  F/m

#### 3.4.3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์คู่ควบการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กล - ไฟฟ้า (electromechanical coupling factor, $k_p$ )

ชิ้นงานที่ผ่านการทำขั้วแล้วถูกทิ้งไว้ 1 วัน จากนั้นนำไปวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงพลังงาน  $k_p$  โดยใช้เครื่องอิมพีแดนซ์อานาไลเซอร์ (impedance Analyzer HP4294A) วัดความถี่เรโซแนนซ์ (resonant frequency,  $f_a$ ) และความถี่แอนตี้เรโซแนนซ์ (antiresonant frequency,  $f_r$ ) เพื่อนำไปคำนวณหาค่า ( $k_p$ ) โดยการใช้สมการ

$$k_p = \left( \frac{f_a - f_r}{0.395f_r + 0.547(f_a - f_r)} \right)^{1/2}$$

เมื่อ  $f_r$  คือความถี่เรโซแนนซ์ (Hz)

$f_a$  คือความถี่แอนตี้เรโซแนนซ์ (Hz)

#### 3.4.4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์คุณภาพเชิงกล (mechanical quality factor, $Q_m$ )

ชิ้นงานที่ผ่านการทำซ้ำ และผ่านการโพลแล้วถูกทิ้งไว้ 1 วัน จากนั้นนำไปวิเคราะห์ค่า  $Q_m$  โดยใช้เครื่อง Impedance Analyzer (HP4294A) วัดความถี่เรโซแนนซ์ (resonant frequency,  $f_r$ ) และความถี่แอนตี้เรโซแนนซ์ (antiresonant frequency,  $f_a$ ) วัดความต้านทานของชิ้นงาน ( $Z_r$ ) ที่ความถี่เรโซแนนซ์ และวัดค่าความจุไฟฟ้า ( $C$ ) ที่ความถี่ 1 Hz เพื่อที่จะนำไปคำนวณหาค่า  $Q_m$  โดยการใช้สมการ

$$Q_m = \frac{f_a^2}{2\pi Z_r C f_r (f_a^2 - f_r^2)}$$

เมื่อ  $Q_m$  คือค่า mechanical quality factor

$f_r$  คือความถี่เรโซแนนซ์ (Hz)

$f_a$  คือความถี่แอนตี้เรโซแนนซ์ (Hz)

$Z_r$  คือความต้านทานที่ความถี่เรโซแนนซ์ (โอห์ม)

$C$  คือความจุไฟฟ้าที่ความถี่ 1 Hz (F)

#### 3.4.5 การวิเคราะห์ค่าวงจรมอดูลาร์รีซีส

ชิ้นงานที่ผ่านการชินเทอร์ และผ่านกระบวนการในการทำซ้ำเรียบร้อยแล้ว นำไปวัดค่าวงจรมอดูลาร์รีซีส โดยใช้เครื่องวัดฮิสเทอรีซิสสูง High voltage interface